



中华人民共和国国家标准

GB/T 6619—1995

硅片弯曲度测试方法

Test methods for bow of silicon slices

1995-04-18 发布

1995-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 6619—1995

硅片弯曲度测试方法

代替 GB 6619—86

Test methods for bow of silicon slices

第一篇 方法 A——接触式测试方法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了硅单晶切割片、研磨片、抛光片(以下简称硅片)弯曲度的接触式测量方法。

本标准适用于测量直径大于 50 mm,厚度为 200~1 000 μm 的圆形硅片的弯曲度。本标准也适用于测量其他半导体圆片弯曲度。

2 方法原理

将硅片置于基准环的 3 个支点上,3 支点形成一个基准平面,用低压力位移指示器测量硅片中心偏离基准平面的距离,该距离表示硅片的弯曲度。

3 测量仪器

3.1 基准环

基准环是由基座、3 个支撑球、3 个定位柱组成的专用器具,如图所示。